

広島大学 HiSIM 研究センター研究員公募

1. 公募人員：研究員 1名
2. 研究分野等：半導体デバイス解析，シミュレーション，コンパクトモデル開発に関する研究。特に次世代半導体デバイス，例えば低電圧動作トランジスタ，有機等の薄膜トランジスタの研究について興味があり，回路シミュレーションモデルへの研究展開にたずさわりたい方。
3. 着任時期：平成 24 年 1 月 1 日以降のできるだけ早い時期
4. 任期：平成 27 年 3 月 31 日まで（業績評価により毎年度に更新を決定する）
5. 待遇：広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則による。（フルタイム契約職員）
6. 応募資格：博士号取得者（見込み可）及びそれに准じる者
7. 提出書類：①履歴書（写真貼付）
②業績リスト（発表論文，国内外学会発表，出願特許等）
③主要論文別刷り（3 編以内）
④これまでの研究概要（1200 字程度）
⑤照会可能な 2 名の氏名・所属・連絡先（メールアドレス，電話番号）
⑥本人の連絡先（メールアドレス，電話番号）
8. 応募締切：随時
9. 書類提出先：〒739-8511
広島県東広島市鏡山 1-3-2
広島大学学術室学術推進グループ総務担当
TEL 082-424-5675
E-mail gakujutu-ssoumu@office.hiroshima-u.ac.jp
「応募書類在中」と朱書し，簡易書留で送付のこと。
10. 選考方法：1) 書類審査
2) 必要に応じて面接を行うことがあります。
11. 問い合わせ先：
〒739-8530 広島県東広島市鏡山 1-3-1
広島大学 HiSIM 研究センター
センター長 マタウシュ ハンス ユルゲン
TEL 082-424-6268, E-mail hjm@hiroshima-u.ac.jp
HP <http://www.hisim.hiroshima-u.ac.jp/>
12. その他：応募書類により取得する個人情報については，採用者の選考及び採用後の人事，給与及び福利関係に必要な手続若しくは統計調査を行う目的で利用するものであり，この目的以外で利用又は提供することはありません。なお，採用に至らなかった方の応募書類は，当該採用選考業務終了後，適切な方法にて廃棄いたします。